

## 新旧対照表

【関税率表解説（令和3年11月30日財関第866号）】

(注) 下線を付した箇所が改正部分である。

| 改正後  | 改正前   |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>第 85 類</b></p> <p>電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品</p> <p style="text-align: center;">(省 略)</p> <p>85.41 半導体デバイス（例えば、ダイオード、トランジスター及び半導体ベースの変換器）、光電性半導体デバイス（光電池（モジュール又はパネルにしてあるかないかを問わない。）を含む。）、発光ダイオード（LED）（他の発光ダイオード（LED）と組み合わせてあるかないかを問わない。）及び圧電結晶素子</p> <p style="text-align: center;">(省 略)</p> <p>(A) 半導体デバイス（例えば、ダイオード、トランジスター、半導体ベースの変換器）<br/> これらは、この類の注12(a)(i)において規定されている。<br/> このグループのデバイスは、ある種の「半導体」物質の電子的特性（これは、例えば、ダイオード、トランジスターに関連する。）に基づいて作動し、又は、半導体ベースの変換器については、物理的（例えば、機械的、熱的）、電気的、光学的、化学的特性を含む半導体の特性に基づいて作動する。<br/> 当該半導体物質の主たる特徴は、室温におけるそれらの抵抗率が金属導体の抵抗率と絶縁体の抵抗率との中間にあることであり、当該半導体物質としては、例えば、ある種の鉱石（例えば、方鉛鉱）、四価の元素（ゲルマニウム、けい素等）及び元素の化合物（例えば、ガリウム砒（<u>ひ</u>）素、インジウムアンチモンのような三価の元素と五価の元素との化合物）がある。</p> <p style="text-align: center;">(省 略)</p> <p>これらには、次の物品を含む。<br/> (I) 及び (II) (省 略)<br/> (III) 半導体ベースの変換器</p> | <p style="text-align: center;"><b>第 85 類</b></p> <p>電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品</p> <p style="text-align: center;">(同 左)</p> <p>85.41 半導体デバイス（例えば、ダイオード、トランジスター及び半導体ベースの変換器）、光電性半導体デバイス（光電池（モジュール又はパネルにしてあるかないかを問わない。）を含む。）、発光ダイオード（LED）（他の発光ダイオード（LED）と組み合わせてあるかないかを問わない。）及び圧電結晶素子</p> <p style="text-align: center;">(同 左)</p> <p>(A) 半導体デバイス（例えば、ダイオード、トランジスター、半導体ベースの変換器）<br/> これらは、この類の注12(a)(i)において規定されている。<br/> このグループのデバイスは、ある種の「半導体」物質の電子的特性に基づいて、又は、半導体ベースの変換器については、物理的（例えば、機械的、熱的）、電気的、光学的、化学的特性を含む半導体特性に基づいて作動する。<br/> 当該物質の主たる特徴は、室温におけるそれらの抵抗率が金属導体の抵抗率と絶縁体の抵抗率との中間にあることであり、当該物質としては、例えば、ある種の鉱石（例えば、方鉛鉱）、四価の元素（ゲルマニウム、けい素等）及び元素の化合物（例えば、ガリウム砒素、インジウムアンチモンのような三価の元素と五価の元素との化合物）がある。</p> <p style="text-align: center;">(同 左)</p> <p>これらには、次の物品を含む。<br/> (I) 及び (II) (同 左)<br/> (III) 半導体ベースの変換器</p> |

新旧対照表

【関税率表解説（令和3年11月30日財関第866号）】

（注）下線を付した箇所が改正部分である。

| 改正後   | 改正前   |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">（省 略）</p> <p>(i) 典型的には相互に接続するための（内部又は外部のワイヤーボンド接続）用の金属製ワイヤー、リードフレーム、封止剤、基板等から成るパッケージ、又は</p> <p>(ii) マグネットや光学素子等、機能を有効化又は補助するコンポーネント素子</p> <p><u>「半導体ベース」の定義については、半導体固有のものに限らず、半導体材料がその特性により変換器に機能性を与えている素子も含む。このような特性には、機械的強度、柔軟性、熱伝導率、光反射率、化学的抵抗性等と、これらが半導体技術（マイクロマシニング）を使用してマイクロメートルスケールで高精度に製造可能であることの組み合わせを含む。これらの素子は、例えば、膜（membranes）、バー、カレンチレバー、キャビティ、ミラー、チャンネル等を含み、その厚みや柔軟性により変換器を機能させている。</u></p> <p><u>半導体ベースの変換器に使用される材料には、例えば、シリコン（Si）、ゲルマニウム（Ge）、炭素（C）、シリコンゲルマニウム（SiGe）、炭化ケイ素（SiC）、窒化ガリウム（GaN）、ガリウム砒（ひ）素（GaAs）、砒（ひ）化インジウムガリウム（InGaAs）、インジウムアンチモン（InSb）、リン化ガリウム（GaP）、リン化インジウム（InP）、スズテルル（SnTe）、酸化亜鉛（ZnO）、酸化ガリウム（Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>）がある。</u></p> <p style="text-align: center;">（省 略）</p> | <p style="text-align: center;">（同 左）</p> <p>(i) 典型的には相互に接続するための（内部又は外部のワイヤーボンド接続）用の金属製ワイヤー、リードフレーム、封止剤、基板等から成るパッケージ、又は</p> <p>(ii) マグネットや光学素子等、機能を有効化又は補助するコンポーネント素子</p> <p><u>「半導体ベース」の定義については、半導体固有のものに限らず、半導体材料がその特性により変換器に機能性を与えている素子も含む。このような特性には、機械的強度、柔軟性、熱伝導率、光反射率、化学的抵抗性等と、これらが半導体技術（マイクロマシニング）を使用してマイクロメートルスケールで高精度に製造可能であることの組み合わせを含む。これらの素子は、例えば、膜（membranes）、バー、カレンチレバー、キャビティ、ミラー、チャンネル等を含み、その厚みや柔軟性により変換器を機能させている。</u></p> <p><u>半導体ベースの変換器に使用される材料には、例えば、シリコン（Si）、ゲルマニウム（Ge）、炭素（C）、シリコンゲルマニウム（SiGe）、炭化ケイ素（SiC）、窒化ガリウム（GaN）、ヒ化ガリウム（GaAs）、ヒ化インジウムガリウム（InGaAs）、リン化ガリウム（GaP）、リン化インジウム（InP）、スズインジウム（InP）、スズテルル（SnTe）、酸化亜鉛（ZnO）、酸化ガリウム（Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>）がある。</u></p> <p style="text-align: center;">（同 左）</p> |